— ХИМИЯ

УДК 544.22.022.33

НОВЫЙ ПОДХОД ПРИ РЕНТГЕНОВСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ МИКРОСТРУКТУРЫ ПЛЁНОК ПЕРЕСЫЩЕННЫХ ТВЁРДЫХ РАСТВОРОВ ЗАМЕЩЕНИЯ Cd, Pb_{1-x}S

И. В. Ваганова^{1,2}, Л. Н. Маскаева^{1,2,*}, В. И. Воронин³, В. Ф. Марков^{1,2}, член-корреспондент РАН В. Г. Бамбуров^{1,4}

Поступило 18.10.2018 г.

Методом коллоидно-химического осаждения синтезированы плёнки пересыщенных твёрдых растворов замещения $Cd_xPb_{1-x}S$ (0 < x < 0,25) толщиной 0,6–1,0 мкм. С использованием модифицированного метода анализа Уильямсона—Холла (МWH) рентгеновских дифракционных спектров определены зависимости плотностей дислокаций, размеров кристаллитов и коэффициентов текстур от содержания в плёнках кадмия.

Ключевые слова: оптоэлектроника, плёнки твёрдых растворов Cd_xPb_{1-x}S, метод Уильямсона–Холла, микроструктура, размер дислокации.

DOI: https://doi.org/10.31857/S0869-56524845554-558

введение

Дальнейшее развитие простых аппаратурнои технологически простых методов синтеза тонкоплёночных полупроводниковых материалов А^{II}–В^{VI} и А^{IV}–В^{VI} для оптоэлектроники остаётся важнейшей задачей для специалистов в области материаловедения. Коллоидно-химический метод осаждения плёнок указанных соединений [1] достаточно успешно позволяет получать пересыщенные твёрдые растворы на основе сульфидов металлов с высокими функциональными свойствами и без проведения специальной операции сенсибилизации. Однако остаётся не до конца установленным влияние условий синтеза плёнок на особенности их строения как материала с заданными характеристиками для практического приложения. Наряду с химическим составом синтезируемых слоёв важными ключевыми параметрами являются их структурное состояние и размеры образующихся при этом частиц. В настоящее время в литературе имеется лишь незначительное число работ по таким структурным особенностям плёнок из различных материалов, как внутренняя деформация, остаточное напряжение, плотность дислокаций. Работы по определению микроструктурных параметров с использованием анализа профиля рентгеновских линий касаются в основном сыпучих материалов и холоднокатаных сплавов [2, 3]. Основная часть работ по анализу рентгеноструктурных особенностей плёнок ограничивается определением размеров кристаллитов из уширения профиля линии рентгеновского рассеяния, игнорируя возможный вклад от её деформации.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В настоящей работе сообщается о результатах исследования порошковым методом плёнок пересыщенных твёрдых растворов $Cd_xPb_{1-x}S$ (0 < x < 0,25), полученных коллоидно-химическим методом осаждения на ситалловую подложку [1, 4]. Осаждение плёнок твёрдого раствора $Cd_xPb_{1-x}S$ проводили из реакционной смеси, содержащей цитратный комплекс свинца $Pb(C_6H_7O_5)OH^{2-}$, аммиачные комплексы кадмия $Cd(NH_3)_{1-6}^{2+}$ и тиокарбамид N_2H_4CS , на предварительно обезжиренные ситалловые подложки. Содержание соли кадмия изменяли от 0,01 до 0,1 моль/л при фиксированных концентрациях соли свинца (0,04 моль/л)

¹ Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, Екатеринбург

² Уральский институт

Государственной противопожарной службы МЧС России, Екатеринбург

³ Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской Академии наук, Екатеринбург

⁴ Институт химии твёрдого тела

Уральского отделения Российской Академии наук, Екатеринбург

^{*} E-mail: mln@ural.ru

и тиокарбамида (0,58 моль/л). Синтез плёнок осуществляли при температуре 353 К в течение 120— 140 мин в герметичных реакторах из молибденового стекла в термостате марки TC-TБ-10.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На рентгенограммах синтезированных плёнок наблюдается набор дифракционных отражений, соответствующих структуре B1, и слабые рефлексы от подложки (рис. 1). С увеличением содержания соли кадмия в реакторе от 0,01 до 0,10 моль/л на полученных рентгенограммах плёнок наблюдается смещение дифракционных отражений в область больших углов (врезка к рис. 1), что соответствует уменьшению периода решётки с 0,59243 до 0,58918 нм. Это интерпретировано нами как образование твёрдых растворов замещения $Cd_{v}Pb_{1-v}S$ со стороны PbS. Уменьшение периода решётки при образовании такого твёрдого раствора обусловлено замещением ионов свинца Pb²⁺ с радиусом 0,120 нм в решётке PbS на ионы кадмия Cd²⁺ с радиусом 0,097 нм. Содержание сульфида кадмия в плёнках твёрдого раствора рассчитывали с использованием правила Вегарда [5], которое согласно [6] с достаточно высокой точностью выполняется для халькогенидных систем.

Различное соотношение интенсивностей дифракционных отражений в рентгенограммах плёнок обусловлено, очевидно, различием преимущественной кристаллографической ориентации наночастиц в изученных плёнках. Уточнение структуры плёнок Cd_xPb_{1-x}S методом полнопрофильного анализа Ритвелда [7] с использованием компьютерной программы FullProf [8] показано на примере синтезированной плёнки твёрдого раствора состава Cd_{0,22}Pb_{0,78}S (рис. 2). Сходимость расчёта и эксперимента (разностная кривая) свидетельствует о правильном выборе типа структуры и модели решётки.

Кроме того, анализ показал, что рефлексы на всех рентгенограммах уширены (рис. 1). Предполагая одновременное влияние размера и деформации наночастиц на ширину рефлексов, использовали уравнение Уильямсона–Холла (conventional Williamson–Hall plot) [9] для определения размера частиц, формирующих пленки твёрдых растворов замещения (TP3) Cd_xPb_{1-x}S и возникающие в них деформации:

$$\beta \cos \Theta = 0.9\lambda/D + 4\epsilon \sin \Theta.$$
 (1)

Здесь *D* — средний размер областей когерентного рассеяния, принимаемого за средний размер частиц, β — полуширина рефлекса в радианах, λ — длина волны используемого рентгеновского излучения, $\varepsilon = \Delta d/d$ — деформация, *d* — межплоскостное расстояние.

Для построения зависимости β соs Θ от sin Θ использовались все рефлексы (врезка к рис. 2). Наклон подгоночной линии указывает на наличие деформаций в частицах, а отсечка на оси ординат (sin $\Theta = 0$) даёт их размер. Таким образом, построенная зависимость подтверждает наличие уширения рефлексов на рентгенограммах синтезированных плёнок, обусловленное размерным



Рис. 1. Рентгенограммы плёнок пересыщенных твёрдых растворов $Cd_{0,05}Pb_{0,95}S(1)$, $Cd_{0,08}Pb_{0,92}S(2)$, $Cd_{0,13}Pb_{0,87}S(3)$, $Cd_{0,22}Pb_{0,78}S(4)$, $Cd_{0,24}Pb_{0,76}S(5)$. Все плёнки содержат кубическую фазу (пр. гр. *Fmm*) со структурой типа *B*1. Излучение $CuK_{\alpha 1,2}$.

ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК том 484 № 5 2019



Рис. 2. Экспериментальная (кружки) и расчётная (сплошная линия) рентгенограммы плёнки ТРЗ состава $Cd_{0,22}Pb_{0,78}S$ с кубической структурой *B*1 (пр. гр. *Fmm*). Линия в нижней части рисунка демонстрирует различие между экспериментальной и расчётной рентгенограммами. Штрихами показано угловое положение рефлексов фазы *B*1 (верхние) и подложки ситалла (нижние). На врезке — экспериментальная зависимость β соs Θ от sin Θ .

и деформационным эффектами. Но поскольку наблюдаются значительные отклонения экспериментальных точек от линейной зависимости $\beta \cos\Theta$ от $\sin\Theta$ (врезка к рис. 2), возможно связанные с существованием деформационной анизотропии в плёночных образцах, то нельзя исключить существенных ошибок в определении размера и величин деформации из традиционных зависимостей Уильямсона–Холла (1). В ряде работ [10-12] показано, что деформационная анизотропия уширения рефлексов в образцах может быть вызвана наличием дислокаций [11]. в частности, сделано предположение о том, что дополнительным фундаментальным параметром является коэффициент контрастности C_{hkl} , определяющий уширение линий при наличии дислокаций вдоль определённых кристаллографических направлений. Было показано, что точность классического метода анализа профилей дифракционных отражений при определении размера и деформаций в кристаллитах плёночного ТРЗ Cd_xPb_{1_x}S будет существенно выше с учётом контрастных факторов дислокаций. В результате для оценки уширения рефлексов предложено уточнённое, названное "модифицированным", уравнение Уильямсона-Холла MWH (a modified Williamson–Hall plot):

$$\Delta K \approx 0.9/D + (\pi M b^2/2)^{1/2} \rho^{1/2} K C^{1/2}, \qquad (2)$$

где K — волновой вектор, равный $2\sin\theta/\lambda$, $\Delta K = 2\cos\theta \cdot \Delta\theta/\lambda$ — физическое уширение линий, ρ — плотность дислокаций (см⁻²), D — средний размер областей когерентного рассеяния, C_{hkl} — средний фактор контраста, определяемый из упругих постоянных тонкоплёночного образца, M — постоянная, зависящая от эффективного внешнего радиуса дислокаций, b — вектор Бюргерса.

На рис. З показаны зависимости физического уширения всех дифракционных отражений ΔK , характерных для кубической фазы *B*1, на примере плёнки ТРЗ Cd_{0,04}Pb_{0,96}S, от *KC*^{1/2}. Уточнённые результаты получены по уравнению (2) с квадратичной подгонкой методом



Рис. 3. Зависимость ΔK от $KC^{1/2}$ для плёнки состава $Cd_{0,04}Pb_{0,96}S$. Кружки — эксперимент, линия — аппроксимация, проведённая методом наименьших квадратов по приведённому модифицированному уравнению (2).

наименьших квадратов. Как видно из рис. 3, наблюдается хорошее соответствие экспериментальных данных с аппроксимационной кривой. Сравнение подгонки тех же данных с использованием традиционного графика Уильямсона-Холла (врезка к рис. 2) показывает, что "модифицированное" уравнение Уильямсона-Холла (2) приводит к гораздо лучшему согласию с экспериментом (рис. 3) и подтверждает наличие анизотропии деформации в плёнке. Из полученных величин коэффициентов первого члена в уравнении (2), равном (0,9/D), установлен средний размер наночастиц, а из второго, пропорционального р^{1/2}, рассчитана плотность дислокаций. Результаты расчёта для плёночных пересыщенных ТРЗ Cd_xPb_{1-x}S представлены в табл. 1. Здесь же приведены данные о наличии в них текстуры типа (200). Эта особенность учитывалась в расчётах интенсивностей поправочного коэффициента текстуры Р1, представляющего собой долю не текстурированного образца по программе FullProf [8]. Результаты анализа показывают, что при

Таблица 1. Характеристика плёнок пересыщенных TP3 $Cd_xPb_{1-x}S$ по параметру кристаллической решётки *a*, плотности дислокаций ρ , размеру кристаллитов *D*, коэффициенту текстуры *P*1 в плёнках $Cd_xPb_{1-x}S$ различного состава

TP3 $Cd_xPb_{1-x}S$	Cd _{0,05} Pb _{0,95} S	Cd _{0,08} Pb _{0,9} 2S	Cd _{0,13} Pb _{0,87} S	Cd _{0,22} Pb _{0,78} S	Cd _{0,24} Pb _{0,76} S
а, нм	0,59243	0,59188	0,59093	0,58951	0,58918
ρ·10 ^{−15} , м ^{−2}	3,8	4,7	10,0	7,3	8,2
<i>D</i> , нм	280	307	386	426	248
<i>P</i> 1	0,88	0,74	0,68	0,66	0,77

синтезе плёнок пересыщенных ТРЗ Cd_xPb_{1-x}S реализуется сложное структурное состояние. Из-за несоответствия параметров решётки PbS и подложки в объёме плёнки возникают дефекты кристаллического строения сульфида свинца и в первую очередь дислокации несоответствия (ДН), которые являются необходимыми равновесными элементами структуры, обеспечивающими релаксацию напряжений [13]. Согласно [14], образование дислокаций происходит при достижении так называемых критических напряжений. Их значения можно регулировать температурой синтеза или отжига, а также легированием изовалентной примесью. В настоящей работе замещение свинца в кристаллической решётке PbS изовалентным кадмием приводит к существенному снижению критических напряжений образования дислокаций и, следовательно, повышению плотности дислокаций до 10^{16} м⁻² при x = 0,132, что приводит к формированию устойчивых тонкоплёночных соединений на основе сульфидов свинца и кадмия с сильно деформированной кристаллической решёткой.

Таким образом, с использованием полнопрофильного анализа рентгенограмм с компьютерным моделированием (программа FullProf) и "модифицированного" уравнения Уильямсона—Холла (MWH) впервые рассчитаны полные структурные характеристики для полученных методом коллоидно-химического осаждения плёнок пересыщенных ТРЗ $Cd_xPb_{1-x}S$. Среди них такие, как период кристаллической решётки, размер кристаллитов, плотность дислокаций и коэффициент текстуры, обеспечили необходимое описание особенностей рассматриваемых плёночных образцов.

При этом установлено, что средние значения размеров кристаллитов, из которых сформированы плёнки $Cd_xPb_{1-x}S$, находятся в диапазоне 250—430 нм с очень высокой плотностью дислокаций порядка 10^{16} м⁻².

Показано, что с увеличением долевой концентрации кадмия в твёрдых растворах Cd_xPb_{1-} _xS возрастают плотность дислокаций, размеры кристаллитов, а также их количество с преимущественной ориентацией (200) в плоскости пленки.

Источник финансирования. Работа выполнена при финансовой поддержке программы 211 Правительства Российской Федерации № 02.А03.21.0006 с использованием УНУ "НМК ИФМ" в рамках государственного задания ФАНО России по темам "Поток" № АААА-А18-118020190112-8 и НИОКР АААА-А16-116122810216-3.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. *Марков В.Ф., Маскаева Л.Н., Иванов П.Н.* Гидрохимическое осаждение пленок сульфидов металлов: моделирование и эксперимент. Екатеринбург: УрО РАН, 2006. 218 с.
- Warren B.E., Averbach B.L. // J. Appl. Phys. 1952.
 V. 23. P. 497–512.
- 3. *Ribarik G., Ungar T.* // Materials Sci. and Eng A. 2010. V. 528. P. 112–121.
- 4. Маскаева Л.Н., Кутявина А.А., Марков В.Ф., Ваганова И.В., Воронин В.И. // ЖОХ. 2018. Т. 88. № 2. С. 319–328.
- 5. *Vegard L.* // Akad. Mat. Naturn Kbisse. 1947. № 2. P. 83.
- 6. *Чичагов А.В., Сипавина Л.В.* Параметры ячеек твердых растворов. М: Наука, 1982. 171 с.
- 7. *Rietveld H.M.* // J. Appl Crystallogr. 1969. V. 2. P. 65–71.
- Rodriguez-Carvajal J. // Physica B. 1993. V. 192. P. 55–59.
- 9. *Williamson G.K., Hall W.H.* // Acta. Metal. 1953. V. 1. P. 22–31.
- Ungar T., Dragomir I., Revesz A., Borbely A. // J. Appl. Cryst. 1999. V. 32. P. 992–1002.
- Ungar T., Borbely A. // Appl. Phys. Lett. 1996. V. 69. № 21. P. 3173–3175.
- Ribárik G., Ungár T. // Materials Sci. and Eng. A. 2010. V. 528. № 1. P. 112–121.
- 13. Сидоров Ю.Г., Якушев М.В., Варавин В.С. и др. // ФТТ. 2015. Т. 57. В. 11. С. 2095—2100.
- Ежлов В.С., Мильвидская А.Г., Молодцова Е.В., Меженный М.В. // Материалы электронной техники. 2013. № 4. С. 13–17.

NEW APPROACH AT X-RAY INVESTIGATION OF MICROSTRUCTURE OF SUPERSATURATED FILMS OF Cd_xPb_{1-x}S SOLID SUBSTITUTIONAL SOLUTIONS

I. V. Vaganova^{1,2}, L. N. Maskaeva^{1,2}, V. I. Voronin³, V. F. Markov^{1,2}, Corresponding Member of the RAS V. G. Bamburov^{1,4}

 ¹ Ural Federal University, Ekaterinburg, Russian Federation
 ² Ural Institute of the State Fire Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and Disaster Relief, Ekaterinburg, Russian Federation
 ³ M.N. Mikheev Institute of Metal Physics of Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russian Federation
 ⁴ Institute of Solid State Chemistry, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russian Federation

Received October 18, 2018

The films of supersaturated $Cd_xPb_{1-x}S$ solid substitutional solutions ($0 \le x \le 0.25$) with thickness $0.6-1.0 \mu m$ were synthesized by chemical bath deposition. The dependences of dislocation density, crystallite sizes and texture coefficient versus the cadmium content in the films were determined by analyzing X-ray diffraction spectra with the use of modified method of Williamson—Hall (MWH).

Keywords: optoelectronics, $Cd_xPb_{1-x}S$ solid solution films, Williamson–Hall method, microstructure, dislocation size.